

## ナノテク総合支援プロジェクトワークショップ プログラム

【11 月13 日 (月)】

10:00～10:10 挨拶

木村 滋 (財)高輝度光科学研究センター ナノテク総合支援プロジェクト推進室長

10:10～10:40 「シリコンナノエレクトロニクス研究での評価技術(放射光)への期待」

財満 鎮明 名古屋大学大学院 教授

10:40～11:10 「硬 X 線光電子分光による極薄 Hf 系酸化膜の化学結合状態および電子状態評価」

宮崎 誠一 広島大学大学院 教授

11:10～11:40 「放射光を用いた次世代集積回路用ゲートスタック構造の評価と材料設計への応用」

知京 豊裕 (独)物質・材料研究機構 半導体材料センター長

11:40～13:00 昼食

13:00～13:30 「放射光を用いた  $\text{La}_2\text{O}_3$  ゲート絶縁膜の構造評価」

角嶋 邦之 東京工業大学大学院 助手

13:30～14:00 「硬 X 線光電子分光法による  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  界面の誘電率の評価」

廣瀬 和之 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 助教授

14:00～14:30 「角度分解光電子分光法による高誘電率ゲート絶縁膜/ $\text{Si}$  界面の評価」

野平 博司 武蔵工業大学大学院 助教授

14:30～15:00 「軟 X 線吸収発光分光法による  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  界面価電子状態のサイト選択的観測」

山下 良之 東京大学 助手

15:00～15:30 休憩

15:30～16:00 「カーボンナノチューブ配線に向けたナノチューブ/金属電極間の界面構造の研究」

近藤 大雄 (株)富士通研究所

16:00～16:30 「X 線マイクロ回折による  $\text{SiGe}/\text{Si}$  系薄膜微細構造の観察」

酒井 朗 名古屋大学大学院 助教授

16:30～17:00 「グローバルおよびローカル歪の測定 —ラマン分光法と SPring-8 の比較と得失について」

小椋 厚志 明治大学 助教授

17:00～17:10 講評

安田 幸夫 高知工科大学 教授

17:30～19:00 懇親会

【11 月14 日 (火)】

- 9:00～9:30 「ナノスケールデバイスに向けたゲートスタック構造の硬 X 線光電子分光解析」  
近藤 博基 名古屋大学大学院 助手
- 9:30～10:00 「硬 X 線光電子分光法によるメタルゲート電極／ゲート絶縁膜界面の解析」  
吉木 昌彦 (株)東芝 研究開発センター
- 10:00～10:30 「トランジスタ用絶縁膜の格子欠陥とひずみの相互作用に基づくナノ領域損傷機構の検討」  
三浦 英生 東北大学大学院 教授
- 10:30～11:00 「放射光光電子分光による FLASH 向けトンネル酸化膜構造の評価」  
劉 紫園 NEC エレクトロニクス(株)
- 11:00～11:30 「極浅接合形成を可能にするプラズマ・ドーピング技術とその最適化のための PES 測定の応用」  
伊藤 裕之 (株)ユー・ジェー・ティー・ラボ
- 11:30～12:00 「光電子顕微鏡を用いた  $\text{HfO}_2/\text{Si}$  界面シリサイド化反応解析」  
安原 隆太郎 東京大学大学院
- 12:00～13:20 昼食
- 13:20～13:40 「BL13XU の現状 (仮題)」  
坂田 修身 (財)高輝度光科学研究センター 主幹研究員
- 13:40～14:00 「BL47XU の現状 (仮題)」  
小林 啓介 (財)高輝度光科学研究センター 特別研究員  
(独)物質・材料研究機構 共用ビームステーション長
- 14:00～14:20 「BL15XU の現状 (仮題)」  
吉川 英樹 (独)物質・材料研究機構 主幹研究員
- 14:20～15:00 総合討論
- 15:00～15:10 閉会挨拶